【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第２区分
【発行日】平成26年12月25日(2014.12.25)

【公開番号】特開2013-105973(P2013-105973A)
【公開日】平成25年5月30日(2013.5.30)
【年通号数】公開・登録公報2013-027
【出願番号】特願2011-250377(P2011-250377)
【国際特許分類】
Ｈ０１Ｌ　33/48　　(2010.01)
【ＦＩ】
Ｈ０１Ｌ　33/00　　４００

【手続補正書】
【提出日】平成26年11月6日(2014.11.6)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１２１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１２１】
発光装置２００の製造方法は、シリコーンエラストマー層３０の表面を活性化処理する工程と、シリコーンエラストマー層３０上に半導体発光素子１０を裁置する工程と、を有する。すなわち、発光装置２００の製造方法によれば、半導体発光素子１０とシリコーンエラストマー層３０を、活性化接合によって接合することができる。したがって、製造工程において、半導体発光素子に加わる損傷を低減することができる。